



2Т8266А,Б

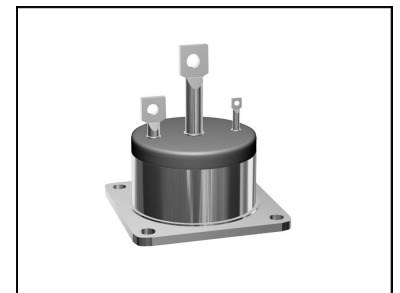
МОЩНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ N-P-N ТРАНЗИСТОР

Применение:

Электропривод

Описание:

Мощные высоковольтные кремниевые n-p-n транзисторы, изготовленные по меза-планарной технологии, в металлокерамическом корпусе с изолированным коллектором



• Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен-ное обозна- чение	Норма		Примечание
		2Т8266А	2Т8266Б	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\ max}$	300	150	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ\ max}$	200	100	1
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ0\ max}$	5	5	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К\ max}$	300	300	1
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К,и\ max}$	400	400	1
Максимально допустимый ток базы, А	$I_{Б\ max}$	50	50	1
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{К\ max}$	300	300	1, 2
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{п\ max}$	150	150	
Максимально допустимая температура корпуса, °С	$T_{К\ макс}$	125	125	

Примечания:

1 В диапазоне температур корпуса от минус 60°С до плюс 125°С.

2 При температуре корпуса свыше 25°С до плюс 125°С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле:

$$P_{К} = \frac{T_{п\ макс} - T_{корп}}{R_{т\ п-к}}, \text{ Вт}$$

где $R_{т\ п-к}$ – установившееся тепловое сопротивление переход-корпус, равное 0,42 °С/Вт.

• Основные электрические параметры

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма				Темпе- ратура (среды) корпуса, °С
		2Т8266А		2Т8266Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=300\text{ В}$), мА	$I_{КБ0}$	-	3,0			25
		-	5,0			-60
		-	6,0			125
(U _{КБ} =150 В), мА				-	3,0	25
				-	5,0	-60
				-	6,0	125
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=5\text{ В}$), мА	$I_{ЭБ0}$	-	25	-	25	25
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КЭ}=5\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$)	$h_{21Э}$	10	-	10	-	25
		8	-	8	-	-60
		8	-	8	-	125
($U_{КЭ}=5\text{ В}$, $I_{К}=300\text{ А}$)		2		2		25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б}=30\text{ А}$), В	$U_{КЭ\text{нас}}$	-	2,0	-	2,0	25
		-	2,5	-	2,5	-60
		-	2,5	-	2,5	125
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б}=30\text{ А}$), В	$U_{БЭ\text{нас}}$		3,0		3,0	25
Граничное напряжение ($I_{К}=0,1\text{ А}$, $L=25\text{ МГн}$), В	$U_{КЭ0гр}$	200	-	100	-	25
Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт	$R_{Тп-к}$		0,42		0,42	

• Временные характеристики

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма				Темпе- ратура (среды) корпуса, °С
		2Т8266А		2Т8266Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Время рассасывания ($U_{КЭ}=50\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б1} = - I_{Б2} = 30\text{ А}$), мкс	$t_{рас}$		3,0		3,0	25
Время спада ($U_{КЭ}=50\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б1} = - I_{Б2} = 30\text{ А}$), мкс	$t_{сп}$		1,0		1,0	25

